第4章习题参考解答

- 4-1 为什么谐振功率放大器能工作于丙类,而电阻性负载功率放大器不能工作于丙类?
- **解**:两种放大器最根本的不同点是:低频功率放大器的工作频率低,但相对频带宽度却很宽,因而只能采用无调谐负载,工作状态只能限于甲类、甲乙类至乙类(限于推挽电路),以免信号严重失真;而高频功率放大器的工作频率高,但相对频带宽度窄,因而可以采用选频网络作为负载,可以在丙类工作状态,由选频网络滤波,避免了输出信号的失真。

详解:

低频功率放大器不能工作在丙类状态,是因为低频相对频率范围比较宽,例如音频频率的范围 20Hz-20KHz,视频范围更宽。而工作在丙类状态的输出信号是尖顶余弦脉冲,严重产生了失真。这种尖顶余弦脉冲经过付里叶级数分解,除了基波分量外,还有丰富的谐波分量,这些谐波分量可能落在音频或视频的范围内,会形成干扰。而高频功率放大器(或谐振功率放大器)一般只对频带很窄的 FM 波或 AM 波进行放大。它所产生的谐波($2f_0,3f_0,4f_0,....$)

已落在 $f_o + \Delta f$ 的范围之外。利用谐振网络只取出有用的基波成分,而滤出谐波成分,使之恢复原来的信号。如果高频信号的频率范围很宽,如电视发射机(或电视差转机),其音频是调频的,而视频是条幅的,且相隔 $6.5 \mathrm{MHz}$,为了使视频信号不失真,其调制带宽为 $8 \mathrm{MHz}$ 左右。这么宽的频带信号经过丙类放大,如果输出谐振回路的带宽不能保证在 $8 \mathrm{MHz}$ 左右,同样会产生失真。因此,电视发射机(或电视差转机)的功率放大器一般工作在甲类状态。

该题的另一种问法: 为什么低频放大器不能工作在丙类,而高频功率放大器可以?

- **4-2** 一谐振功率放大器,若选择甲、乙、丙三种不同工作状态下的集电极效率分别为: η_{cp} =50%, η_{cz} =75%, η_{cp} =85%。试求:
 - (1) 当输出功率 $P_0=5W$ 时,三种不同工作状态下的集电极耗散功率 P_C 各为多少?
- (2) 若保持晶体管的集电极耗散功率 $P_{c}=1W$ 时,求三种不同工作状态下的输出功率 P_{o} 各为多少?
- 解:通过本题的演算,能具体了解集电极效率对集电极耗散功率和输出功率的影响。
 - (1) 根据集电极效率 nc的定义

$$\eta_c = \frac{P_o}{P_D} = \frac{P_o}{P_o + P_c}$$

可得

$$P_c = \frac{1 - \eta_c}{\eta_c} P_o$$

将ηҫҕ、ηҫҳ、ηҫҕ分别代入上式可得

 P_{c} $_{\parallel}$ = P_{o} =5W, P_{c} $_{\perp}$ =0.33 P_{o} =1.65W, P_{c} $_{\parallel}$ =0.176 P_{o} =0.88W 可看出 η_{c} 越高,相应的 P_{c} 就越小。

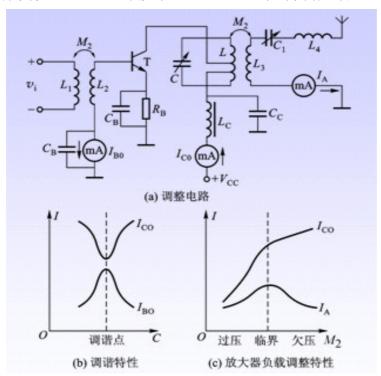
(2) 从 Pc 的表达式可以推导出

$$P_o = \frac{\eta_c}{1 - \eta_c} P_c$$

将 Л с ₹ 、 Л с ⊼ 分别代入上式得

 $P_{o \, \text{P}} = P_{c} = 1$ W, $P_{o \, \text{Z}} = 3P_{c} = 3$ W, $P_{o \, \text{P}} = 5.67P_{c} = 5.67$ W 可见,在 P_{c} 相同时,效率越高,输出功率就越大。

- **4-3** 丙类放大器为什么一定要用调谐回路作为集电极(阳极)负载?回路为什么一定要调到谐振状态?回路失谐将产生什么结果?
- 解:选用谐振回路作为集电极负载的原因是为了消除信号的失真。只有在谐振时调谐回路才能有效地滤除不需要的信号,只让有用信号输出。此时,集电极电流脉冲只在集电极瞬时电压最低区间流通,因而电流脉冲最小,平均电流 Ico 也最小。若回路失真,则集电极电流脉冲位移到集电极电压较高的区间流通,因而电流脉冲变大。Ico 上升。同时,输出功率下降,集电极耗散功率将急剧增加,以致烧坏放大管。因此。回路失谐必须绝对避免。



4-4 某一晶体管谐振功率放大器,设已知 V_{CC} =24V, I_{C0} =250mA, P_{o} =5W,电压利用系数 ξ =1。试求 P_{D} 、 η_{c} 、 R_{p} 、 I_{cm1} 、电流通角 θ_{c} (用折线法)。

#:
$$P_D = V_{CC}I_{C0} = (24 \times 0.25)W = 6W$$

$$\eta_c = \frac{P_o}{P_D} = \frac{5}{6} = 0.833 = 83.3\%$$

$$V_{cm} = \xi V_{CC} = 1 \times 24V = 24V$$

$$R_{p} = \frac{1}{2P_{o}} V_{cm}^{2} = 57.6\Omega \qquad (\because P_{o} = \frac{1}{2} I_{cm1} V_{cm} = \frac{1}{2R_{p}} V_{cm}^{2})$$

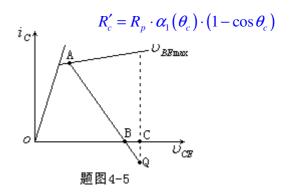
$$I_{cm1} = \frac{2P_{o}}{V_{cm}} = \frac{2 \times 5}{24} A = 0.417A$$

$$g_1(\theta_c) = \frac{I_{cm1}}{I_{C0}} = \frac{417}{250} = 1.67$$

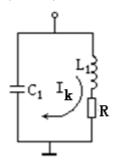
查原书附录 4.1, 得出此时的 $\theta_c = 78^\circ$

4-5 在题图 4-5 中:

- (1)当电源电压为 V_{CC} (图中的 C 点)时,动态特性曲线为什么不是从 $\upsilon_{CE} = V_{CC}$ 的 C 点画起,而是从 Q 画起?
 - (2) 当 θ c 为多少时, 才从 C 点画起?
- (3) 电流脉冲是从 B 点才开始发生的,在 BQ 这段区间并没有电流,为何此时有电压降 BC 存在?物理意义是什么?



- \mathbf{M} : (1) 由于放大器工作于丙类, θ_c <90°,因此从 \mathbf{Q} 点画起。
 - (2) 当 θ_c =90° 时,才从 C 点画起。此时,放大器工作在乙类状态下。
- (3) BC 这段电压是由谐振回路的滤波作用, 所产生的基波电压。因此 BC 段虽然没有电流, 但仍然有电压降。它的物理意义是谐振回路的储能作用。
- **4-6** 晶体管放大器工作于临界状态, η $_c$ =70%, V_{CC} =12V, V_{cm} =10.8V,回路电流 I_k =2A (有效值),回路电阻 R=1 Ω 。试求 θ $_c$ 与 P_o 。
- 解:回路电流的概念如图,依题意代表有效值。



$$P_o = I_k^2 R = 2^2 * 1W = 4W$$

$$P_{D} = \frac{\eta_{c}}{P_{o}} = \frac{4}{0.7}W = 5.7W$$

$$P_{c} = P_{D} - P_{o} = 1.7W$$

$$I_{c0} = \frac{P_{D}}{V_{cc}} = 0.475W$$

$$I_{cm1} = \frac{2P_{o}}{V_{cm}} = 0.74A$$

波形系数为:
$$g_1(\theta_c) = \frac{I_{cm1}}{I_{C0}} = \frac{0.74}{0.475} = 1.56$$

查表 4.1 可得: $\theta_c = 91^\circ$

4-7 由高频功率晶体管 2SC3102 组成的谐振功率放大器,其工作频率 f=520MHz,输出功率 $P_o=60W$, $V_{CC}=12.5V$ 。

(1) 当 η_{C} =60%时,试计算管耗 P_{C} 和平均分量 I_{C0} 值; (2) 若保持 P_{o} 不变,将 η_{C} 提高 到 80%,试问 P_{C} 减少多少?

解: (1) 由 $\eta_c = \frac{P_o}{P_D}$ 得

$$P_{D} = \frac{P_{o}}{\eta_{c}} = \frac{60W}{0.6} = 100W; \qquad P_{c} = P_{D} - P_{o} = 40W$$

$$I_{c0} = \frac{P_{D}}{V_{cc}} = \frac{100W}{12.5V} = 8A$$

(2)

$$P_{D}' = \frac{P_{o}}{\eta_{c}} = \frac{60W}{0.8} = 75W; \qquad P_{c}' = P_{D}' - P_{o} = 15W$$

$$I_{c0}' = \frac{P_{D}'}{V_{cc}} = \frac{75W}{12.5V} = 6A$$

$$\therefore \Delta P_{c} = P_{c} - P_{c}' = 40W - 15W = 25W$$

4-8 试证谐振功率放大器输出至谐振回路 R, 的功率恰等于谐振回路电阻 R 所消耗的功率。

证:回路的最大电流值 I_{km} 与集电极电流基波振幅 I_{CM} 之间的关系为: $I_{km} = QI_{cm}$

回路电阻 \mathbf{R} (理解为电感的串联电阻)与回路并联谐振电阻 $\mathbf{R}_{\mathbf{p}}$ 关系为: $\mathbf{R}_{p}=\mathbf{Q}^{2}\mathbf{R}$

回路所获得的功率为: $Po = \frac{1}{2}I_{cm}^2R_p = \frac{1}{2}(\frac{I_{km}}{Q})^2Q^2R = \frac{1}{2}I_{km}^2R$

- **4-9** 高频大功率晶体管 3DA4 参数为 f_T =100MHz,β =20,集电极最大允许耗散功率 P_{CM} =20W,饱和临界线跨导 g_{cr} =0.8A / V,用它做成 2MHz 的谐振功率放大器,选定 V_{CC} =24V, θ_c =70°, i_{Cmax} =2.2A,并工作于临界状态。试计算 R_p 、 P_o 、 P_c 、 $η_c$ 与 P_D 。
- 解: 由 $i_C = g_{cr}v_{CE}$, 当 $v_{CE} = v_{CE \min}$ 时, $i_C = i_{C \max}$, 因此得

参考:

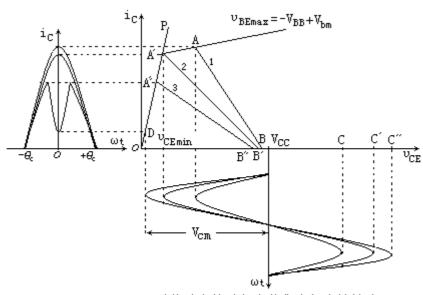


图4-2-2 不同٧㎝时的动态线及相应的集电极电流波形

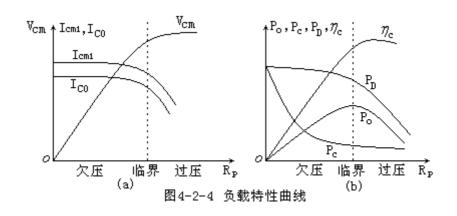
4-10 放大器工作于临界状态,根据理想化负载特性曲线,求出当 R_p (1) 增加一倍,(2) 减小一半时, P_o 如何变化?

解: (1)
$$P_o = \frac{1}{2} I_{cm1}^2 R_p = \frac{1}{2} \frac{V_{cm}^2}{R_p}$$

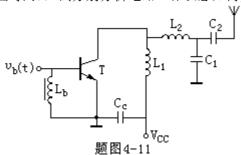
由负载特性可见,当 R_p 增加一倍时,放大器由临界转入过压状态, V_{cm} 几乎不变, P_o 约下降一半。

(2) 当 R_p 减小一半时,放大器将由临界转入欠压状态, I_{cml} 几乎不变, P_o 也将约下降一半。

参考:



4-11 题图 4-11 所示为末级谐振功率放大器原理电路,工作于临界状态。图中 C_2 为耦合电容,输出谐振回路由管子输出电容、 L_1 、 L_2 和 C_1 组成,外接负载天线的等效阻抗近似为电阻。将天线短路,开路(短时间),试分别分析电路工作状态如何变化?晶体管工作是否安全?



解: 天线开路时,回路的品质因数增大,导致 R_p 急剧增加,结果是 V_{cm} 增大使功率管工作于强过压状态。在强过压状态下, V_{cm} 有可能大于 V_{CC} ,结果使 $v_{CEmax} > V_{(BR)}$ CEO,功率管被击穿。

天线短路时,回路严重失谐(呈感性),且阻抗 $Z_p << R_p$,使功率管工作于欠压状态, P_c 增大,很可能导致 $P_c > P_{CM}$,功率管烧坏。

同类对比补充:

对于图 4-3-4 复合输出回路,如果发生下列情况之一,则集电极直流表的读数应该如何变化? (1) 天线断路: (2) 天线接地(短路): (3) 中介回路失谐。

解:(1)天线断开,相当于天线回路反射到中介回路的电阻 r'=0。

 $(\because r' = \frac{\omega M^2}{R_A}, R_A = 0, \therefore r' = \infty)$ 。因此,中介回路的 R_p 增加,放大器由临介转入过压, I_{co}

下降,因此集电极直流电表读数减小。天线回路的高频电流表读数为零。

- (2) 当天线短路时,天线回路反射到中介回路的电阻 $r' = \infty$, 因此中介回路的 $R_p = 0$,此时,放大器由临界转入欠压, I_{co} 微升,同时天线电流表有读数。
- (3) 若中介回路失谐,则 Ico 急剧上升,甚至导致晶体管烧毁,天线电流表的读数急剧下降。

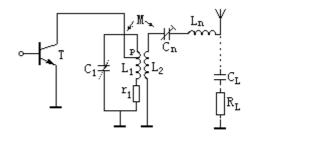
复习公式:

$$Z_{12} = \frac{(\omega M)^2}{Z_{22}} = \frac{(\omega M)^2}{|Z_{22}|^2} R_{22} + j \frac{-(\omega M)}{|Z_{22}|^2} X_{22}$$

$$Z_{21} = \frac{(\omega M)^2}{Z_{11}} = \frac{(\omega M)^2}{|Z_{11}|^2} R_{11} + j \frac{-(\omega M)^2}{|Z_{11}|^2} X_{11}$$

$$R_{p} = \frac{L}{Cr} = \frac{\omega_{p}^{2}L^{2}}{r} = Q_{p}\omega_{p}L; R_{p} = \frac{L}{Cr} = \frac{1}{\omega_{p}^{2}C^{2}r} = Q_{p}\frac{1}{\omega_{p}C}; R_{p} = Q_{p}^{2}r$$

$$Q = \frac{R_p}{\omega L} = \frac{\omega L}{r}$$



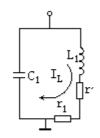


图4-3-4 复合式输出回路

图4-3-5 复合式输出回路的等效电路

$$R''_{p} = \frac{L_{1}P^{2}}{C_{1}(r_{1} + r')} = \frac{L_{1}}{C_{1}\left(r_{1} + \frac{\omega M^{2}}{R_{A}}\right)}P^{2}$$

- **4-12** 一谐振功率放大器,设计在临界工作状态,经测试得输出功率 P_o 仅为设计值的 60%,而 I_{CO} 却略大于设计值。试问该放大器处于何种工作状态?分析产生这种状态的原因。
- **解**: R_p 小,导致放大器进入欠压状态。原因是放大器由临界状态进入欠压状态时,集电极电流脉冲高度增大,导致 I_{C0} 和 I_{clm} 略有增大,但 V_{cm} 因 R_p 而减小,结果是 P_o 减小, P_D 增大, n_c 减小。

参见:图 4-2-4 负载特性曲线。

4-13 设计一工作于临界状态的谐振功率放大器,实测得效率 n_c 接近设计值,但 I_{Co} 、 P_o 、 P_c 均明显小于设计值,回路调谐于基波,试分析电路工作状态,现欲将它调到临界状态,

应改变哪些参数?不同调谐方法所得的功率是否相同?

- 解:根据题意可知放大器工作于过压状态(参见图 4-2-4 负载特性曲线),因为由临介状态 进入过压时, η_{C} 变化不大,但由于集电极电流脉冲出现凹陷,使 I_{co} 、 I_{cml} 减小,从而使 P_{o} 、 Pp、Pc减小。为了使谐振功放处于临界状态可改变下列电量:
- (1) 保持 V_{BB} 、 V_{bm} 、 V_{cc} 不变,减小 R_e ,使其趋向临界状态,在这种情况下,由于 V_{BEmax} 和管子导通时间不变, ic 凹陷消失, 使放大器的 Ico、Icm1 上升, 导致 Po、PD、 nc上升。
- (2) 增大 V_{cc} ,保持 R_{e} 、 V_{bm} 、 V_{BB} 不变,使放大器回到临界状态。由于 R_{e} 不变,输出功率 功率较(1)大。

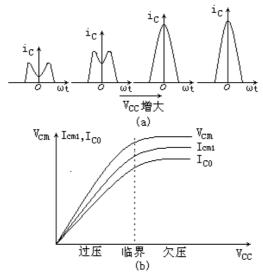


图4-2-5 集电极调制特性(Vcc对工作状态的影响)

(3) 其他不变,减少 V_{bm} , 导致 V_{cm} 减小,使放大器的工作状态从过压趋向临界,这是, 由于 V_{BEmax} 和和导通时间减小(或导通角减少),导致 ic 的高度减小,宽度变窄,结果使 I_{c0} 、 I_{cm1} 减小,输出功率比前 2 种情况小。

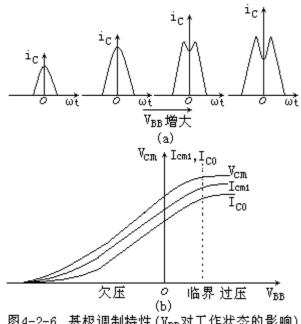
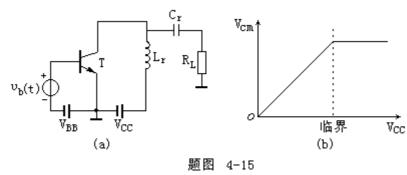


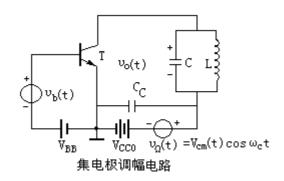
图4-2-6 基极调制特性(VBB对工作状态的影响)

4-14 设两个谐振功率放大器具有相同的回路元件参数,它们的输出功率 P。分别为 1W 和 0.6W。若增大两放大器的 V_{CC} ,发现其中 $P_o=1W$ 放大器的输出功率增加不明显,而 $P_o=0.6W$ 放大器的输出功率增加明显,试分析其原因。若要增大 P_o=1W 放大器的输出功率,试问还应同时采取什么措施(不考虑功率管的安全工作问题)?

- **解:** (1) Po=1W 的放大器原工作于临界状态或欠压状态,增大 Vcc 时,放大器进入或更趋于欠压状态,Icm1 略有增大。因此,Po 增大不明显。为了增大输出功率就必须在增大 Vcc 的同时,增大 R_p 或 V_{BB} 或两者同时增加。其中,增大 R_p 使 V_{cc} 增大,增大 V_{BB} 使 I_{cm1} 增大,他们都可以使 P_o 增大。
- (2)Po=0.6W 的放大器原工作于过压状态。增大 Vcc 时,放大器趋向临界状态,使 Icm1 迅速增大,从而使 P_0 增大。
- **4-15** 题图 **4-15** (a) 所示为谐振功率放大器原理图,原工作在临界状态,现欲将它改为集电极调幅电路,电路应如何改动?若要求调幅指数为 1,则 V_{CC} 和 V_{Ω_m} 应如何调整?设集电极调制特性为理想折线,如图 **4-15** (b) 所示,试画出负载上的电压波形。



解:



上图是集电极条幅电路。要将其工作状态改为过压状态。图

4-16 在调谐某一晶体管谐振功率放大器时,发现输出功率与集电极效率正常,但所需激励功率过大。如何解决这一问题?假设为固定偏压。

解:输出功率和效率正常,说明集电极电路没有问题。激励功率过大的原因是基电极偏压过小,工作与欠压状态,以致需要基极电流过大。解决的方法是加大基极偏压,使放大器工作到过压状态。

4-17 在图 4-3-4 所示的电路中,测得 $P_D = 10W$, $P_c = 3W$,中介回路损耗功率 $P_k = 1W$ 。试求: (1) 天线回路功率 P_L ; (2) 中介回路效率 η_k ; (3) 晶体管效率和整个放大器的效率。

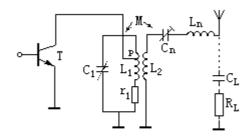


图4-3-4 复合式输出回路

解:晶体管输出功率为:

$$P_{o} = P_{D} - P_{c} = 10W - 3W = 7W$$

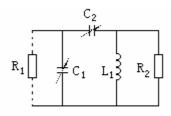
中介回路效率:
$$\eta_k = \frac{P_o - P_k}{P_o} = \frac{7 - 1}{7} = 85.7\%$$

天线回路功率: $P_A = P_o - P_k = 6W$

晶体管的效率:
$$\eta_c = \frac{P_o}{P_D} = \frac{7}{10} = 70\%$$

整个放大器的效率:
$$\eta = \frac{P_A}{P_D} = \frac{P_A}{P_o} * \frac{P_o}{P_D} = \eta_k * \eta_c = 0.7 * 0.857 = 0.6 = 60\%$$

4-18 有一输出功率为 2W 的晶体管高频功率放大器,采用题 图 4-18 的 π 型匹配网络,负载电阻 R_2 =200 Ω , V_{CC} =24V, f=50MHz。设 Q_L =10,试求 L_1 、 C_1 、 C_2 之值。



题图4-18 π形匹配网络

$$\mathbf{MF:} \quad R_p = R_1 = \frac{V_{cm}^2}{2P_o} = \frac{24^2}{2*2}\Omega = 144\Omega$$

$$\therefore X_{c1} = \frac{R_1}{Q_L} = \frac{144\Omega}{10}\Omega = 14.4\Omega$$

$$\therefore C_1 = \frac{1}{\omega X_1} = \frac{1}{2*\pi*5*10^6*14.4}F = 221pF$$

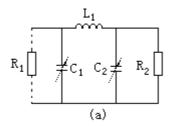
$$\mathbb{Z}: : X_{c2} = \sqrt{\frac{R_2}{\sqrt{(1+Q_L^2)\frac{R_2}{R_1}-1}}} = \sqrt{\frac{50}{\sqrt{(1+10^2)\frac{50}{144}-1}}} \Omega = 8.57\Omega$$

$$\therefore C_2 = \frac{1}{\omega X_{c2}} = \frac{1}{2\pi * 50 * 10^6 * 8.57} F = 371 pF$$

$$X: : X_{L1} = \frac{Q_L R_1}{Q_L^2 + 1} (1 + \frac{R_2}{Q_L X_{C2}}) = \frac{10*144}{10^2 + 1} (1 + \frac{50}{10*8.57}) \Omega = 22.6 \Omega$$

故得:
$$\therefore L_1 = \frac{X_{L1}}{\omega} = \frac{22.6}{2\pi * 50 * 10^6} H = 72nF$$

4-19 已知晶体管功率放大器,工作频率=100MHz, R_L =50 Ω , P_o =1W, V_{CC} =12V,饱和压降 V_{CE} (sat) =0.5V, $C_{b'e}$ =40pF。试设计一个 π 型匹配网络(提示:晶体管的输出电容 C_o =2 $C_{b'e}$)。



解: 采用上图的 π 形匹配网络,有

$$R_p = R_1 = \frac{V_{cm}^2}{2P_0} = \frac{(V_{cc} - V_{CE(SAT)})^2}{2P_0} = \frac{(12 - 0.5)^2}{2*1} \Omega$$

晶体管的输出电容约为 $C_o=2C_{b'e}=80pF$,先假设是 C_1 的一部分。设 $Q_L=10$,则:

$$X_{c1} = \frac{R_1}{Q_L} = \frac{66}{10}\Omega$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega X_{C1}} = \frac{1}{2\pi * 100 * 10^6 * 6.6}F = 241pF$$

再考虑到晶体管的输出电容 $C_o = 2C_{b'e} = 80pF$, 实际所需的电容为:

$$C_1' = C_1 - C_0 = 161 pF$$

$$X_{c2} = \sqrt{\frac{R_2}{\sqrt{(1+Q_L^2)\frac{R_2}{R_1}-1}}} = \sqrt{\frac{50}{\sqrt{(1+10^2)\frac{50}{66}-1}}}\Omega = 5.75\Omega$$

$$C_2 = \frac{1}{\omega X_{C2}} = \frac{1}{2\pi * 100 * 10^6 * 5.75} F = 277 pF$$

$$X_{L1} = \frac{Q_L R_1}{Q_L^2 + 1} (1 + \frac{R_2}{Q_L X_{C2}}) = \frac{10 * 66}{10^2 + 1} (1 + \frac{50}{10 * 5.75}) \Omega = 12.2 \Omega$$

$$L_1 = \frac{X_{L1}}{\omega} = \frac{12.2}{2\pi * 100 * 10^6} H = 19.4 nH$$

- 4-20 试比较下列两种放大器的输出功率与效率:
 - (1) 输入与输出信号均为正弦波, 电流为尖顶余弦脉冲(丙类);
 - (2)输入与输出信号均为方波,电流为方波脉冲(丁类)。 假定在这两种情况下的电压与电流幅度均相等,负载回路也相同。
- **解:** 假设在以上两种情况下的 i_{cmax} 相等, $\theta_c = 90^\circ$,则对于正弦波状态

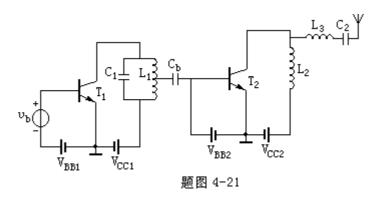
$$I_{co} = 0.319i_{c \max}, \qquad I_{cm1} = 0.5i_{c \max}$$

对于方波状态:
$$I_{co} = 0.5i_{c \max}$$
, $I_{cml} = \frac{2}{\pi}i_{c \max} = 0.637i_{c \max}$

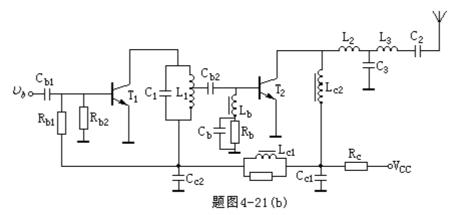
若两种状态的 Vcm 相同,则可知,由于 I_{cm1} > I_{cm1} , 因而,方波状态的直流输入功率也大。 两者的效率比较,可由 Icm1/Ico 之值看出:

正弦波的效率正比于 0.5/0.319=1.56; 方波的效率正比于 0.637/0.5=1.27。因此,正弦状态的效率较高。

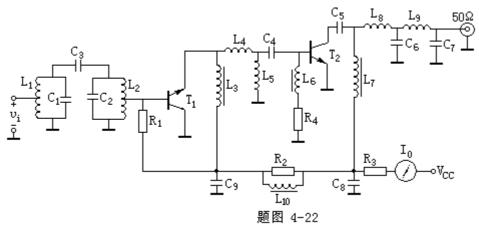
4-21 根据题图 4-21 所示的谐振功率放大器原理电路,按下列要求画出它的实用电路。(1) 两级放大器共用一个电源;(2) T_2 管的集电极采用并馈电路,基极采用自给偏置电路;(3) T_1 管的集电极采用串馈电路,基极采用分压式偏置电路。



解: 根据题意要求画出的电路如题图 4-21 (b) 所示。图中,两级共用一个电源。电源线 必须串接电源滤波网络 R_{C1} 、 C_{C1} 、 C_{C2} 。 T_2 管基极接高频扼流圈 L_b ,提供直流通路,并利用扼流圈的直流电阻产生自给偏压。 T_2 管集电极接高频扼流圈 L_{c2} ,组成并馈电路。在 L_2 和 L_3 的接点上并接电容 C_3 ,构成 T 型匹配滤波网络。



4-22 题图 4-22 所示为 132~140MHz 的 3W 调频发射机末级、末前级原理电路,两级均为共发射极放大器,图中有多处错误,试改正。



解: 目的: 改正谐振功放电路的错误,以熟悉谐振功放电路的组成。

题图 4-22 电路有如下错误:

- (1) 第一级电路不是共发电路,不合题设要求;
- (2) T_1 管基极和输入回路之间无隔直电容,造成 T_1 管基极对地直流短路,无法提供所需偏置。
 - (3) T₂基极电阻 R₄上无旁路电容,减弱了自给偏置效应;
- (4) 电流表上无旁路电容,导致交流信号流过电流表,既影响电流表的准确度,又消耗交流信号能量。
 - (5) T_2 管集电极上电容 C_5 将直流电源隔断,应去除。

改正电路如题图 4-22(b) 所示。

